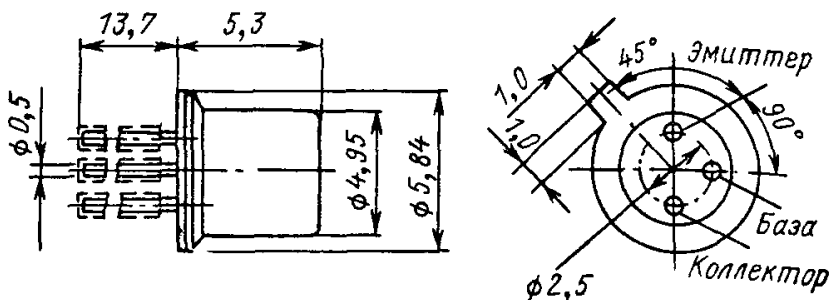


КТ349А, КТ349Б, КТ349В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* СВЧ универсальные маломощные

Предназначены для переключения и усиления сигналов высокой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА не менее **300 МГц**
 Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 10$ мА.

КТ349А	20–80
КТ349Б	40–160
КТ349В	120–130
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не более	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15$ В, $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм не более	1,5 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ не более	8 пФ

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
 Энергоатомиздат, 1985

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 1$ мс	40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 233 - 303$ К	200 мВт
при $T = 358$	108 мВт
Общее тепловое сопротивление	600 К/Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985